

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 3 部門第 4 区分  
 【発行日】平成 17 年 10 月 27 日 (2005.10.27)

【公開番号】特開 2000-17422 (P2000-17422A)

【公開日】平成 12 年 1 月 18 日 (2000.1.18)

【出願番号】特願 平 10-191769

【国際特許分類第 7 版】

C 2 3 C 14/04

C 2 3 C 16/04

G 0 2 B 5/20

H 0 1 L 21/203

H 0 1 L 21/285

【F I】

C 2 3 C 14/04 A

C 2 3 C 16/04

G 0 2 B 5/20

H 0 1 L 21/203 S

H 0 1 L 21/285 S

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 7 月 6 日 (2005.7.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

マスクの基板と接触する側とは反対の面の表層に凹凸を設けたことを特徴とする導電膜パターン化用マスク。

【請求項 2】

上記凹凸を形成した面の中心線平均粗さ  $R_a$  が  $0.1$  から  $5 \mu m$  の範囲内であることを特徴とする請求項 1 記載の導電膜のパターン化用マスク。

【請求項 3】

上記凹凸をサンドブラスト処理により表層を粗らすことで形成することを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の導電膜パターン化用マスク。

【請求項 4】

上記凹凸をエッチングにより形成することを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の導電膜パターン化用マスク。

【請求項 5】

上記凹凸をハーフエッチングにより、マスクの厚み方向に部分的に窪みを付けることで形成することを特徴とする請求項 1、2 または 4 のいずれかに記載の導電膜パターン化用マスク。

【請求項 6】

請求項 1 ~ 5 のいずれかに記載のパターン化用マスクを用いることを特徴とする透明導電膜の製膜方法。